

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0211U002762

Державний реєстраційний номер: 0108U003557

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-02-2011

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Структура та властивості шарів неорганічних сцинтиляторів A2B6 та фторидів

Початок етапу: 01.2008

Закінчення етапу: 12.2010

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 23756522

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (057)341-01-37, 340-44-74

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 783.925
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Структура та властивості шарів неорганічних сцинтиляторів A₂B₆ та фторидів

Назва роботи англійською:

Structure and properties of inorganic scintillators A₂B₆ layers and fluorides

Реферат українською:

Досліджено напівпровідникові сполуки ZnSe(Te) і ZnTe з погляду їх структури, морфології та сцинтиляційних характеристик та проведені дослідження виявленого ефекту незмочування відколу кристала LiF орієнтації (100) напиленою плівкою CsI.

Реферат англійською:

Compound semiconductors ZnSe(Te) and ZnTe from the point of their structure, morphology and scintillation characteristics were examined and the research of uncovered nonwetting effect of LiF crystal chip at the orientation (100) by evaporated film CsI was carried out

Індекс УДК: 661:548.55; 661.539.1.074; 661.143, 539.1.074.3:546.16:621.382.2/.3

Коди тематичних рубрик: 61.69.37

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Ширан Наталія Володимирівна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Методи кількошарового напилення активованих напівпровідникових матеріалів на кремнієві фотодіоди і досліджені їх параметри

Назва НТП англійською: The methods of multilayer evaporation of activated semiconductor materials on silicon photodiodes and their investigated parameters.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування:

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Були вивчені умови росту шарів ZnSe(Te) у вакуумі, що сприяють формуванню стовпчастої морфології. Виконані експерименти по вирощуванню у вакуумі шарів ZnSe(Te) товщиною до 1 мм, які володіють стовпчастою морфологією, вивчені режими росту, що відповідають моделі структурних зон. Обмірювані їх сцинтиляційні характеристики. Напилюванням у вакуумі отримані шари ZnTe товщиною до 2 мм і вивчені особливості їхнього окислювання в потоці кисню при різних температурах.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: не відомо

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: -

Перспективні ринки: -

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. Fedorov A. Vacuum Deposited ZnSe(Te) Scintillating Layers / A. Fedorov, K. Katrunov, A. Lalayants [a. o.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2008. V. 55. P. 1561 1562.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Гектін Олександр Вульфович

Перелік осіб-виконавців

Лебединский А. М.

Федоров А. Г.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

